7.7	13	Формат	Зона	FOI	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
имен.	PEYH. 941615. UUZ	*)			РЕУН.468323.001 СБ 2D	<u>Документация</u> Сборочный чертеж		*)ЛД,А4
Перв. примен.	PEVH. 94	*)			PEVH.468323.001 33 2D	Схема электрическая принципиальная		*)ЛД, А4
		*) PEVH.468323.001 ПЭЗ ТЭ				Перечень элементов		*)ЛД, А4
		*)			РЕУН.468323.001 ВП ТЭ	Ведомость покупных изделий		*)ЛД, А4
Cnpaß. N						<u>Сборочные единицы</u>		
		*)		2	РЕУН.687253.003 ТЭ	Плата печатная	1	*)ЛД, А4
						Прочие изделия		
Подп. и дата		5				Резонатор ABS07—120—32.768КНZ—Т	1	BQ1
Инв. И дубл.				7		<u>Резонатор NX2520SA—16MHZ—STD—CSW—5</u> фирма NDK, Япония	1	<i>BQ2</i>
Взам. инв. N								
Инв. N подл. Подп. и дата В		<u>1</u> Изм. Раз П <u>р</u> Н. к	ТЭ Лист 1	Листов 10				

	Формат	Зона	7703	Обозначение	Наименование	Кол	Приме— чание
			9		Конденсатор GRM21BR60J226ME39L	1	C25
					фирма Murata Manufacturing, Япония		
					Конденсаторы фирма Yageo, Тайвань		
			12		CC0603JRNP09BN120	4	C8,C9,C18,C1
			14		CC0603KRX7R9BB333	1	C22
			16		CC0603MRX5R7BB105	18	C7,C26-C40
							C47,C52
gama			10		CC0C077DV5V0DD104	21	01 00 04 06
2			18		CC0603ZRY5V9BB104		C1, C2, C4, C6
Nogn.							C11-C17,C23 C24,C41-C46
rg/b							C48-C51,C55
N 9							
Инв.							
>	Щ		20		CC0603KRX7R9BB103	1	C3
инв.	\square						
Взам.			0.5				
	\mathbb{H}		22		CC0603JRX7R9BB103	2	C53, C54
u gama	\mathbb{H}						
Nogn. u			24		CC0603KRX7R9BB104	1	C56
подл.							
Инв. N	Изм	<i> </i>	$\sim m$	N докум. Подп. Дата	PEYH. 468323. 001	Tŝ	<u>Лис</u> г

	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
	Ш				Конденсаторы фирма Yageo, Тайвань		
	\blacksquare		26		CC0805KKX7R7BB475	1	C10
			28		CC0805KKX5R9BB106	1	C57
			30		CC1206KKX5R8BB106	1	C5
			32		Не устанавливать	2	C20,C21
			<i>34</i>		Микросхема K7805—500R3	1	DA1
					фирма Mornsun Power, Китай		
Подп. и дата					фирма ST Microelectronics, Швейцария		
rg/b	-		<i>37</i>		Микросхема LM2902D	1	DA8
Инв. N			70			,	0.4.7
. инв. N			39		Микросхема TS4962IQT	1	DA3
л Взам.			41		Микросхема TLV70233DBVT	1	DA2
n. u gama					фирма Texas Instruments, США		
л Подп.			43		Микросхема RS3007—5.0AYF3	1	DA7
Инв.И подл.			$\frac{\parallel}{\parallel}$		фирма Runic, Китай ЕУН. 468323. 001	<u> </u> <i>T</i> コ	Лис
Z	Изм	Ли	ст	N докум. Подп. Дата Копирова			лат A4

	Формат	Зона	Обозначение	Наименование	Кол	Приме— чание
	П					
		45	;	Не устанавливать	3	DA4,DA5,
	H					DA6
		47		Микросхема CP2102N—A02—GQFN20R фирма Silicon Labs, США	1	DD5
		49		Микросхема MAX232ID	3	DD2-DD4
				фирма Texas Instruments, США		
		51		Микросхемы STM32F446RET6	1	DD1
gama				фирма ST Microelectronics, Швейцария		
Nogn. u gc		53	7	24LCO4B/SN	1	DD6
дубл				фирма Microchip Technology, США		
Инв. N		55	<u></u>	Предохранитель MF—SMDF050—2	1	FP1
инв. М				фирма Bourns, США		
Взам.	$\frac{1}{2}$	57	7	Светодиоды APT1608EC	3	HL1-HL3
u gama	H			фирма Kingbright, Тайвань		
Подп.	H				2	111 1111 5
подл		59	7	Не устанавливать		HL4,HL5
Инв.N подл.	Изм	Лист	N докум. Подп. Дата	PEYH. 468323.001	ТЭ	<i>Лис</i> 4

	Формат	Зона	1703	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
					Ферритовая бусина		
					фирма Murata, Япония		
			61		BLM18AG102SN1D	5	L2-L6
			63		BLM18TG102TN1D	1	L1
					Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
ŀ					гезисторы фирма тадео, тайойны		
}	4	_	66		RC0603FR-070RL	16	R1–R3,
ŀ					NOUGOTH UTONE	70	R48,R54,R5
Ī							R65,R71,R7
							 R82,R88,R90
[R94,R98,
gama							R121,R12.
06 n							
ngoi i	\dashv	+	68		RC0603FR-0722RL	4	D15 D16 D
roAb			00		NCUOUJFN-U722NL	- 4	R15,R16,R9 R92
<i>(</i> 6							NJZ
MH0.							
<u> </u>			70		RC0603FR-0762RL	1	R130
пно.							
B3QM.	_						
\top	\dashv	\dashv	72		RC0603FR-07100RL	3	R21,R128,R12
dama	\dashv	-	_				
n Jodu: n	\dashv	\dashv	74		RC0603FR-071KL	5	R19,R20,R2
Ĭ			, ,		MOODON OF INC	J	R25,R95
il bc							1120,1100
инс. м подл.					PEYH. 468323. 001	<i>T</i> \(\)	Ли

	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме— чание
					Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
			<i>77</i>		RC0603FR-071K5L	3	R17,R93,R11
			<i>79</i>		RC0603FR-074K7L	3	R37,R99,
			73		NOUUSIN UTTIVE	J	R100
			01		D000075D 0740W	40	20 24 24
			81		RC0603FR-0710KL	12	R6,R11,R14 R26,R45,R62
							R79,R115-R11 R120,R126
na	_		83		RC0603FR-0720KL	4	R111–R113,
Подп. и дата							R131
удб	<u> </u>		85		RC0603FR-0722KL	1	R97
Инв. N							
инв. N			87		RC0603FR-0727KL	1	R118
л Взам.			89		RC0603FR-0747KL	1	R96
. u gama							
Подп.			91		RC0603FR-0751KL	1	R125
Инв.N подл							Лис
Инв.	Изм	л Ли	ст	N докум. Подп. Дата	PEУН. 468323. 001 Копировал		6 Mam A4

	Формат	Зона	Поз	Обозначе	ение		Наименование	Кол	Приме- чание
							Резисторы фирма Yageo, Тайван	b	
	H	\dashv	\dashv						
			94				RC0603FR-0756KL	1	R114
			96				RC0603FR-07100KL	18	R4,R5,
									R7-R10,R1.
		<u> </u>							R127
			98				RC0603FR-07150KL	2	R38,R39
			100				RC0603FR-071ML	1	R18
n. u gama		+							
л Подп.		1							
Инв. N дубл		+	102				Не устанавливать	54	R23,R24,R27-R
N	\Box								R30-R36 R40-R43,R44,
пнв.									R46,R47,R49-R
Взам.	\square	_	4						R55,R57-R61,F
	\vdash	-	4						R64,R66-R70
gama	dash	\dashv	\dashv						R72,R74-R77
Подп. и	\dashv	\dashv	\dashv					 	R78,R80,R8
1/6	H	\dashv	\dashv						R83–R86,R8 R89,R110,
ъдл	H	\dashv	\dashv						R123,R124
Инв.N подл.	Изм.			N докум. Подп.	Дата	P	EYH. 468323. 001	<i>T.</i> Э	Пи

	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	кол	Приме- чание
	Н						
	Н				7 24 2 4 4 244		
	Н				Диоды фирма ON Semiconductor, США		
			104		MBR130LSFT1G	1	VD5
	Щ						
	Н		400		04545454		10110
	H		106		SMF15AT1G	4	VD1-VD3, VD14
	Н						VU14
			108		SM05T1G	5	VD4,
							VD10-VD1
	Н						
	H		110		Пиод СМА 115A	1	VD6
DQ.	H		110		Диод SMAJ15A фирма Diodes Incorporated США	,	VDO
u gama					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Подп	Щ						
	arpropto		112		Не устанавливать	3	VD7-VD9
N дубл	Н						
Инв.	Н		114		Транзисторы 2N7002К	9	VT1 – VT5,
` 	┨				фирма ON Semiconductor, США		VT15-VT18
инв.	Щ						
Взам.	Н		100				1/70 1/74
ma	H		109		Не устанавливать	9	VT6-VT14
u gama							
Подп.							
	Щ						
Инв.N подл.							
1нв.N	Изм		1,	докум. Подп. Дата	PEYH. 468323.001	ТЭ	Лис 8

	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
	Ш				Вилки фирма Connfly Electronic, Kumaŭ		
	Ш		111		DS1066-02MVW6	6	X4-X9
			113		DS1066-04MVW6	1	X10
			115		DS1069-2MVW6X	1	X1
			117			1	V11
			117		Розетка SHDR-20V-S-B(P) фирма JST Corporation,Япония	<i>1</i>	X11
			119		Вилка 87834—0819	3	X12-X14
gama	Ш				фирма Molex, США		
Nogn. u gc			121		Розетка 1050170001 фирма Molex, США	2	X15,X16
l gy6л	H				фирма іногех, США		
Инв. N			123		Не устанавливать	2	X2,X3
инв. М	\mathbb{H}						
Взам. и							
gama							
Подп. и д							
подл							
Инв.И подл	Изм	Лu	cm I	N докум. Подп. Дата	PEYH. 468323. 001	<i>TЭ</i>	Ли

	НОІ	мера лист	ов (стра	————— нии)	Bcezo	и изменен			
Изм			новых	анулиро- ванных	листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопрово- дительного документа и дата	Подпись	Дат
H									
\vdash				<u> </u>					
-									
-									
				1					
H					DEVH /	168327	3.001 T		Лисп